

日程表(会場別1)

会場名	2022年9月20日(火)		2022年9月21日(水)		2022年9月22日(木)		2022年9月23日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
A101	09:00 ~ 12:00 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11) 2.1 検出器デバイス開発	13:15 ~ 17:45 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11) 2.1 検出器デバイス開発	09:00 ~ 12:00 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11) 9.3 ナノエレクトロニクス	13:15 ~ 17:45 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11) 9.3 ナノエレクトロニクス	09:00 ~ 10:45 3.11 ナノ領域光学・近接場光学 (旧3.12) 13.5 デバイス/配線/集積化技術	15:45 ~ 18:30 CS.4 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11)・3.11 ナノ領域光学・近接場光学 (旧3.12) のコトシエ7	09:00 ~ 11:30 3.11 ナノ領域光学・近接場光学 (旧3.12) 09:00 ~ 12:00 2.5 放射線誘起蛍光体	13:00 ~ 16:30 3.11 ナノ領域光学・近接場光学 (旧3.12) 13:00 ~ 16:45 2.5 放射線誘起蛍光体
A102	09:00 ~ 12:00 2.1 検出器デバイス開発	13:00 ~ 16:00 2.1 検出器デバイス開発	09:30 ~ 11:15 9.3 ナノエレクトロニクス	13:00 ~ 15:45 9.3 ナノエレクトロニクス	09:00 ~ 11:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:00 ~ 17:45 2.4 医用応用	09:00 ~ 12:00 2.5 放射線誘起蛍光体	13:00 ~ 16:45 2.5 放射線誘起蛍光体
A105	09:00 ~ 11:30 8.1 プラズマ生成・診断	14:00 ~ 17:00 8.1 プラズマ生成・診断	09:00 ~ 11:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:00 ~ 15:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	09:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:00 ~ 18:45 12.7 医用工学・バイオチップ	09:00 ~ 12:30 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 17:00 12.7 医用工学・バイオチップ
A106	09:00 ~ 11:00 8.4 プラズマラプラエンス	14:00 ~ 17:15 8.4 プラズマラプラエンス	09:00 ~ 11:15 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	13:00 ~ 17:45 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	09:00 ~ 11:15 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:00 ~ 17:45 12.6 ナノバイオテクノロジー		
A200	09:00 ~ 11:30 17.3 騰伏物質	13:30 ~ 18:10 T22 方晶壁/バルクの新しい機能の発見から現在まで~研究の現状と展望。応用可能性~	09:00 ~ 12:30 CS.10 12.6 ナノバイオテクノロジー・12.7 医用工学・バイオチップのコードシフト	13:30 ~ 17:45 T12 スピンエレクトロニクス研究のトンド今後の展望 ~スピントロニクス研究会20周年記念シンポジウム~	09:40 ~ 12:00 NT2 就活生必見! 私は応物で就職を決めました ~ 養成する半導体業界で働く我々からのメッセージ~	13:30 ~ 18:00 T18 半導体を用いた量子情報技術の最新線	13:30 ~ 16:30 NT1 人を拡張する新しいインターフェースの最新線	13:30 ~ 16:30 NT1 人を拡張する新しいインターフェースの最新線
A202	09:00 ~ 11:00 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2) [材料・機器光学と統合]	13:00 ~ 18:00 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2) [材料・機器光学と統合]	09:30 ~ 11:15 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)	13:00 ~ 16:30 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)	09:00 ~ 11:30 6.2 カーボン系薄膜	13:00 ~ 19:00 6.2 カーボン系薄膜	09:00 ~ 11:30 6.2 カーボン系薄膜	13:00 ~ 17:00 6.2 カーボン系薄膜
A205	09:00 ~ 11:30 6.6 フロー顕微鏡	13:00 ~ 16:30 6.6 フロー顕微鏡	09:00 ~ 11:45 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15)	13:00 ~ 18:45 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15)	09:00 ~ 12:00 10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術	13:30 ~ 18:30 10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術	09:00 ~ 12:30 10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術	
A301	13:15 ~ 16:45 1.5 計測技術・計測標準	13:15 ~ 16:45 1.5 計測技術・計測標準	13:00 ~ 16:45 1.3 新技術・複合新領域	13:00 ~ 16:45 1.3 新技術・複合新領域	09:00 ~ 11:15 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:30 ~ 17:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス		
A302	13:00 ~ 15:30 1.1 応用物理一般・学際領域	13:00 ~ 15:30 1.1 応用物理一般・学際領域	09:00 ~ 11:00 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:00 ~ 15:30 11.1 基礎物性	09:15 ~ 11:30 11.1 基礎物性	13:00 ~ 16:30 11.1 基礎物性		
A304	13:00 ~ 17:15 9.1 誘電材料・誘電体	13:00 ~ 17:15 9.1 誘電材料・誘電体	09:00 ~ 11:00 16.2 エナジーハーベスティング	13:00 ~ 16:45 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	09:00 ~ 11:30 11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用			
A306	14:00 ~ 16:30 チュートリアル(高温超伝導入門: 直観的に理解する基礎から物質まで)	14:00 ~ 16:30 チュートリアル(高温超伝導入門: 直観的に理解する基礎から物質まで)	09:00 ~ 11:30 3.6 レーザー・プロセス (旧3.7)	13:00 ~ 17:30 11.4 アナログ応用および関連技術	09:00 ~ 11:30 11.4 アナログ応用および関連技術	13:00 ~ 14:45 11.5 接合, 回路作製プロセスおよびシミュレーション	09:00 ~ 11:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	13:00 ~ 16:15 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境
A307	10:00 ~ 11:30 T15 ハテロ材料が拓く新機能	13:00 ~ 16:45 T15 ハテロ材料が拓く新機能	09:00 ~ 11:15 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2) [材料・機器光学と統合]	13:30 ~ 17:15 T23 トロポカルフォトニクス/メカニクスとその周辺科学の展開	09:00 ~ 10:45 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 18:00 CS.7 6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技術, 13.5 デバイス/配線/集積化技術のコトシエ7	09:30 ~ 10:45 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	13:30 ~ 15:30 T2 科学教育の人的育成および教育の取組とその活性化-東北地区-
A401	13:30 ~ 17:40 T14 次世代ICTと未来医療を支える神経科学・神経工学・脳型コンピューティング	13:30 ~ 17:40 T14 次世代ICTと未来医療を支える神経科学・神経工学・脳型コンピューティング	10:00 ~ 12:05 T11 人工嗅覚エレクトロニクス・インフォマティクスの研究最新線と展望	13:30 ~ 16:15 T11 人工嗅覚エレクトロニクス・インフォマティクスの研究最新線と展望	10:00 ~ 11:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:30 ~ 18:30 T7 群知能の新興: 生物・ロボット・材料の創発をみ出す	10:00 ~ 11:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	
A402	13:00 ~ 14:30 9.4 熱電変換	13:00 ~ 14:30 9.4 熱電変換			09:00 ~ 11:30 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)	13:00 ~ 16:30 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)		
A404	09:00 ~ 11:30 3.9 量子物理・技術 (旧3.10)	13:00 ~ 17:45 3.9 量子物理・技術 (旧3.10)	09:00 ~ 11:30 3.9 量子物理・技術 (旧3.10)	13:00 ~ 17:45 3.11 ナノ領域光学・近接場光学 (旧3.12)	09:00 ~ 09:30 7.4 量子ドット界面構造計測	15:15 ~ 15:30 8.6 Plasma Electronics English Session		
A406	09:00 ~ 11:30 13.4 Si系プロセス・S系薄膜・MEMS・装置技術	13:00 ~ 16:30 13.4 Si系プロセス・S系薄膜・MEMS・装置技術	09:00 ~ 11:15 13.4 Si系プロセス・S系薄膜・MEMS・装置技術	15:00 ~ 17:30 13.4 Si系プロセス・S系薄膜・MEMS・装置技術	09:00 ~ 10:15 8.2 プラズマ薄膜・エッチング・表面処理技術	13:00 ~ 17:00 8.2 プラズマ薄膜・エッチング・表面処理技術	09:00 ~ 10:15 3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14)	13:00 ~ 15:45 3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14)

日程表(会場別2)

会場名	収容人数	2022年9月20日(火)			2022年9月21日(水)			2022年9月22日(木)			2022年9月23日(金)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後		
B101	88	09:30 ~ 12:15 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術 13:45 ~ 17:30 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	13:45 ~ 17:30 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	09:30 ~ 12:00 T13 ベロロカイトによる次世代材料の創成と応用展開	13:30 ~ 16:30 T13 ベロロカイトによる次世代材料の創成と応用展開	09:00 ~ 12:00 FS.1 フォーカストセクション(AI)レクドニクス	13:30 ~ 17:45 T8 先端計測と機能性酸化物研究の共通化	09:00 ~ 11:45 8.2 フラスタ膜・エッチング・表面処理	13:30 ~ 17:00 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	09:00 ~ 11:45 8.2 フラスタ膜・エッチング・表面処理	13:30 ~ 17:00 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	09:00 ~ 11:45 8.2 フラスタ膜・エッチング・表面処理	13:30 ~ 17:00 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート
B102	88	09:45 ~ 12:05 T20 エネルギーハーベスティングの新展開	13:30 ~ 16:50 T20 エネルギーハーベスティングの新展開	09:00 ~ 12:00 T13 ベロロカイトによる次世代材料の創成と応用展開	13:30 ~ 17:50 T6 別視点でベンチャーとそれを支える仕組みへフォトリソグラフィの進化	09:00 ~ 10:30 15.2 II-V族膜および多元素結晶	13:30 ~ 17:30 T17 特色ある分光評価法による半導体発光材料・光物性再訪・新しい展開を目指して	09:00 ~ 12:00 12.5 有機太陽電池	13:30 ~ 15:45 8.3 フラスタ膜・エッチング・表面処理	09:00 ~ 12:00 12.5 有機太陽電池	13:30 ~ 15:45 8.3 フラスタ膜・エッチング・表面処理	09:00 ~ 12:00 12.5 有機太陽電池	13:30 ~ 15:45 8.3 フラスタ膜・エッチング・表面処理
B103	88	09:00 ~ 12:15 6.1 強誘電体薄膜	13:30 ~ 19:00 6.1 強誘電体薄膜	09:00 ~ 12:10 T3 コロリウムにおける放射線計測技術の最新動向	13:30 ~ 17:45 T21 ガラス系イオン伝導体の層前線〜2022 年国際ガラス生 YVOG 記念シンポジウム	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	13:30 ~ 18:30 2.5 有機太陽電池	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	13:30 ~ 17:00 12.5 有機太陽電池	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	13:30 ~ 17:00 12.5 有機太陽電池	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	13:30 ~ 17:00 12.5 有機太陽電池
B104	88	09:00 ~ 12:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 19:00 12.4 有機EL・トランジスタ	09:00 ~ 12:00 10.5 磁場応用	13:30 ~ 17:30 T19 グリーン化に挑戦する半導体製造・プロセス技術	09:30 ~ 12:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 17:30 12.4 有機EL・トランジスタ	09:00 ~ 12:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 17:30 12.4 有機EL・トランジスタ	09:00 ~ 12:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 17:30 12.4 有機EL・トランジスタ	09:00 ~ 12:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 17:30 12.4 有機EL・トランジスタ
B200	105	09:00 ~ 11:10 T5 最先端で活躍するガラスとガラス状態〜2022 年国際ガラス生 YVOG 記念シンポジウム	13:30 ~ 17:35 T5 最先端で活躍するガラスとガラス状態〜2022 年国際ガラス生 YVOG 記念シンポジウム	09:00 ~ 10:00 8.8 フラスタ膜・エッチング・表面処理の最新動向	13:15 ~ 18:45 T9 細胞運動を制御する応用物理：フラスタ膜・エッチング・表面処理の最新動向	09:00 ~ 11:55 T10 アカデミア・企業から見た熱電研究の最新動向(MI)駆動型研究からIoT応用まで	13:30 ~ 17:35 T10 アカデミア・企業から見た熱電研究の最新動向(MI)駆動型研究からIoT応用まで	09:00 ~ 11:50 T24 計測インフラの革新と応用	13:00 ~ 17:00 T24 計測インフラの革新と応用	09:00 ~ 11:50 T24 計測インフラの革新と応用	13:00 ~ 17:00 T24 計測インフラの革新と応用	09:00 ~ 11:50 T24 計測インフラの革新と応用	13:00 ~ 17:00 T24 計測インフラの革新と応用
B201	88	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 2.1 検出器デバイス開発	13:30 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 16:15 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	09:00 ~ 12:15 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関電子デバイス	13:45 ~ 16:45 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関電子デバイス	09:00 ~ 12:15 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関電子デバイス	13:45 ~ 16:45 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関電子デバイス	09:00 ~ 12:15 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関電子デバイス	13:45 ~ 16:45 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関電子デバイス
B202	88	10:00 ~ 11:00 授賞式	13:30 ~ 16:30 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 17:00 13.9 化合物太陽電池	09:00 ~ 12:00 17.2 グラフェン	13:30 ~ 18:00 17.2 グラフェン	09:00 ~ 12:00 17.2 グラフェン	13:30 ~ 17:00 17.2 グラフェン	09:00 ~ 12:00 17.2 グラフェン	13:30 ~ 17:00 17.2 グラフェン	09:00 ~ 12:00 17.2 グラフェン	13:30 ~ 17:00 17.2 グラフェン
B203	88	09:00 ~ 11:45 21.1 合同セクションK「フロンティア」 酸化半導体材料・デバイス	13:00 ~ 19:00 21.1 合同セクションK「フロンティア」 酸化半導体材料・デバイス	09:00 ~ 12:00 21.1 合同セクションK「フロンティア」 酸化半導体材料・デバイス	13:15 ~ 18:45 21.1 合同セクションK「フロンティア」 酸化半導体材料・デバイス	09:00 ~ 11:45 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	13:30 ~ 19:00 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	09:00 ~ 12:00 13.7 化合物及びワイヤデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 15:45 13.7 化合物及びワイヤデバイス・プロセス技術・評価	09:00 ~ 12:00 13.7 化合物及びワイヤデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 15:45 13.7 化合物及びワイヤデバイス・プロセス技術・評価	09:00 ~ 12:00 13.7 化合物及びワイヤデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 15:45 13.7 化合物及びワイヤデバイス・プロセス技術・評価
C101	66	09:00 ~ 12:30 7.3 微細(ナノ)・微細構造形成技術	13:30 ~ 18:15 16.3 シリコン系太陽電池	09:00 ~ 12:00 13.8 光物性・発光デバイス	13:30 ~ 17:30 13.8 光物性・発光デバイス	09:00 ~ 12:15 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:45 ~ 17:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	09:00 ~ 12:15 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:45 ~ 17:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	09:00 ~ 12:15 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:45 ~ 17:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	09:00 ~ 12:15 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:45 ~ 17:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性
C102	66	09:45 ~ 11:45 9.5 新機能材料・新物性	13:30 ~ 17:45 9.5 新機能材料・新物性	09:00 ~ 12:00 9.4 熱電変換	13:30 ~ 16:30 9.4 熱電変換	09:00 ~ 12:00 22.1 合同セクションM「フロンティア」 アインシュタイン	13:30 ~ 18:00 22.1 合同セクションM「フロンティア」 アインシュタイン	09:00 ~ 12:00 22.1 合同セクションM「フロンティア」 アインシュタイン	13:30 ~ 16:45 22.1 合同セクションM「フロンティア」 アインシュタイン	09:00 ~ 12:00 22.1 合同セクションM「フロンティア」 アインシュタイン	13:30 ~ 16:45 22.1 合同セクションM「フロンティア」 アインシュタイン	09:00 ~ 12:00 22.1 合同セクションM「フロンティア」 アインシュタイン	13:30 ~ 16:45 22.1 合同セクションM「フロンティア」 アインシュタイン
C105	66	09:00 ~ 12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 17:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:00 ~ 12:15 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 16:30 13.5 デバイス/配線/集積化技術	09:00 ~ 11:45 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 18:00 12.2 評価・基礎物性	09:00 ~ 11:15 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 16:45 12.2 評価・基礎物性	09:00 ~ 11:15 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 16:45 12.2 評価・基礎物性	09:00 ~ 11:15 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 16:45 12.2 評価・基礎物性
C106	66	09:00 ~ 11:30 12.1 作製・構造制御	13:30 ~ 18:30 12.1 作製・構造制御	09:00 ~ 11:45 12.1 作製・構造制御	13:30 ~ 16:30 12.1 作製・構造制御	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 16:30 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 16:30 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 16:30 15.4 III-V族窒化物結晶
C200	166	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:30 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 16:15 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 16:30 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 16:30 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 16:30 15.4 III-V族窒化物結晶
C201	66	09:30 ~ 11:30 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	13:30 ~ 15:45 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	09:00 ~ 12:00 FS.1 フォーカストセクション(AI)レクドニクス	13:30 ~ 17:45 FS.1 フォーカストセクション(AI)レクドニクス	09:00 ~ 11:45 3.8 テラヘルツ全線 (旧B3.9)	16:00 ~ 17:30 3.8 テラヘルツ全線 (旧B3.9)	09:00 ~ 11:45 3.8 テラヘルツ全線 (旧B3.9)	16:00 ~ 17:30 3.8 テラヘルツ全線 (旧B3.9)	09:00 ~ 11:45 3.8 テラヘルツ全線 (旧B3.9)	16:00 ~ 17:30 3.8 テラヘルツ全線 (旧B3.9)	09:00 ~ 11:45 3.8 テラヘルツ全線 (旧B3.9)	16:00 ~ 17:30 3.8 テラヘルツ全線 (旧B3.9)
C202	66	09:00 ~ 12:00 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	13:30 ~ 15:45 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	09:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 17:45 17.3 層状物質	09:00 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料	13:00 ~ 16:15 6.4 薄膜新材料	09:00 ~ 12:00 6.4 薄膜新材料	13:00 ~ 16:00 6.4 薄膜新材料	09:00 ~ 12:00 6.4 薄膜新材料	13:00 ~ 16:00 6.4 薄膜新材料	09:00 ~ 12:00 6.4 薄膜新材料	13:00 ~ 16:00 6.4 薄膜新材料
C205	66	13:30 ~ 17:15 CS.2.3.2 情報フォトリソグラフィ・画像工学 (旧B3.3) / 4.4 Information Photonicsのコードシフト	13:30 ~ 17:15 CS.2.3.2 情報フォトリソグラフィ・画像工学 (旧B3.3) / 4.4 Information Photonicsのコードシフト	10:00 ~ 12:00 CS.2.3.2 情報フォトリソグラフィ・画像工学 (旧B3.3) / 4.4 Information Photonicsのコードシフト	13:30 ~ 17:45 CS.2.3.2 情報フォトリソグラフィ・画像工学 (旧B3.3) / 4.4 Information Photonicsのコードシフト	13:30 ~ 17:45 CS.1.2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析 / 7.5 イオンビーム一般のコードシフト	13:30 ~ 17:45 CS.1.2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析 / 7.5 イオンビーム一般のコードシフト	09:30 ~ 11:15 4.3 Lasers and laser materials processing	13:15 ~ 17:00 4.3 Lasers and laser materials processing	09:30 ~ 11:15 4.3 Lasers and laser materials processing	13:15 ~ 17:00 4.3 Lasers and laser materials processing	09:30 ~ 11:15 4.3 Lasers and laser materials processing	13:15 ~ 17:00 4.3 Lasers and laser materials processing
C206	66	09:30 ~ 11:45 15.1 ハルチ結晶成長	13:30 ~ 16:45 15.1 ハルチ結晶成長	09:00 ~ 12:30 13.1 Si系窒化物・表面界面・シリコン	13:30 ~ 17:00 13.1 Si系窒化物・表面界面・シリコン	09:00 ~ 12:00 3.5 超高速・高強度レーザー (旧B3.6)	13:30 ~ 17:00 3.5 超高速・高強度レーザー (旧B3.6)	09:00 ~ 11:00 3.5 超高速・高強度レーザー (旧B3.6)	13:30 ~ 16:45 3.5 超高速・高強度レーザー (旧B3.6)	09:00 ~ 11:00 3.5 超高速・高強度レーザー (旧B3.6)	13:30 ~ 16:45 3.5 超高速・高強度レーザー (旧B3.6)	09:00 ~ 11:00 3.5 超高速・高強度レーザー (旧B3.6)	13:30 ~ 16:45 3.5 超高速・高強度レーザー (旧B3.6)

日程表(会場別3)

会場名	2022年9月20日(火)		2022年9月21日(水)		2022年9月22日(木)		2022年9月23日(金)		
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
C301	09:00 ~ 11:45 3.3 生体・医用光学 (旧3.4)	13:30 ~ 18:15 3.3 生体・医用光学 (旧3.4)	09:00 ~ 11:45 3.12 半導体デバイス (旧3.13)	13:30 ~ 16:15 3.12 半導体デバイス (旧3.13)	09:00 ~ 12:00 3.6 レーザープロセッシング (旧3.7)	13:30 ~ 18:15 3.6 レーザープロセッシング (旧3.7)	09:00 ~ 12:00 3.6 レーザープロセッシング (旧3.7)	13:30 ~ 16:00 3.6 レーザープロセッシング (旧3.7)	
C302	09:00 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料	13:30 ~ 16:45 6.4 薄膜新材料	09:00 ~ 12:30 4.5 Nanocarbon and 2D Materials	13:30 ~ 15:45 4.8 Optics Special Lecture 16:15 ~ 19:00 4.7 Quantum Optics and Nonlinear Optics	09:00 ~ 10:30 4.7 Quantum Optics and Nonlinear Optics	13:30 ~ 18:15 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	09:00 ~ 11:30 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	13:30 ~ 16:30 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	
C304	09:00 ~ 12:15 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	13:30 ~ 17:30 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	09:00 ~ 11:45 4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics	13:30 ~ 15:15 4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics					
C306	09:00 ~ 12:00 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:30 ~ 15:45 15.6 IV族系化合物 (SiC)	09:00 ~ 11:45 7.2 電子ビーム応用	13:30 ~ 14:45 7.2 電子ビーム応用					
C401		13:30 ~ 18:00 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス							
M206	09:00 ~ 12:00 FS.1 フォークキャストセッション「AIILレトロニクス」	13:30 ~ 18:15 T2.5 インテリアルAIILレトロニクス	09:00 ~ 12:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 17:35 T16 ワイドバンドギャップ半導体MOS界 面科学の最新動向	09:00 ~ 12:00 23.1 合同セッション「インフォマテイクス 応用」	13:30 ~ 18:00 23.1 合同セッション「インフォマテイクス 応用」	09:00 ~ 12:00 FS.1 フォークキャストセッション「AIILレトロ ニクス」	13:30 ~ 17:00 FS.1 フォークキャストセッション「AIILレトロ ニクス」	
P01 ～ P20	09:30-11:30 1.3 新技術・複合新領域 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 1.5 計測技術・計測標準 1.6 超音波 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュ レーション 13.2 探索的材料物性・基礎物性 23.1 合同セッション「インフォマテイクス 応用」	13:30-15:30 6.5 表面物理・真空 12.5 有機太陽電池	09:30-11:30 6.2 カーボン系薄膜 10.2 エレクトロニクス・マグネティクス 11 超伝導 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30-15:30 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2 「材料・機器光学」併合) 3.2 情報フォトニクス・画像工学 (旧 3.3) 3.3 生体・医用光学 (旧3.4) 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5) 3.6 レーザープロセッシング (旧3.7) 3.9 光量子物理・技術 (旧3.10) 9.1 誘電材料・誘電体 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート 9.4 熱電変換 9.5 新機能材料・新物性 16.3 シリコン系太陽電池 17 ナノカーボン FS.1 フォークキャストセッション「AIILレトロ ニクス」	09:30-11:30 1.2 教育 2 放射線 6.6 フロープロセッシング 8 プラスミクエレクトロニクス	13:30-15:30 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8) 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9) 3.10 フォトリソグラフィ・構造・現象 (旧 3.11) 3.11 ナノ領域光学・近接場光学 (旧3.12) 3.12 半導体デバイス (旧3.13) 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニク ス (旧3.15) 6.3 酸化エレクトロニクス 13.9 化合物太陽電池 15.1 ハルゲン化物成長 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エビ タキシンの基礎 15.5 IV族結晶, IV-V族結晶 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 [16:00-18:00] 12.1 作製・構造制御 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子 デバイス 13.8 光物性・発光デバイス 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 15.4 III-V族窒化物結晶	09:30-11:30 3.5 超高速・高強度レーザー (旧 3.6) 3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧 3.14) 7 ビーム応用 13.3 絶縁層技術 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・ 装置技術 21 合同セッション「ワイヤチップ酸化 物半導体材料・デバイス」		
		16:00-18:00 9.3 ナノエレクトロニクス 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセ ス技術・評価 15.6 IV族系化合物 (SiC)	16:00-18:00 2 放射線 6.1 強誘電体薄膜 6.4 強誘電新材料 12.2 評価・基礎物性 12.3 機能材料・萌芽的デバイス						